

ارائه مبدل DC/DC افزایشده ولتاژ با قابلیت ارتباط مستقیم بین منبع و بار

ابراهیم سالاری^{۱*}، سجاد سبزی^۲

* ۱- گروه برق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

۲- گروه برق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱/۱۵ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۳/۲۰

چکیده: در این مقاله یک نمونه از مبدل‌های DC/DC افزایشده که دارای ضریب بهره بالاتری نسبت به مبدل‌های افزایشده کلاسیک است برای استفاده در سیستم‌های فتوولتائیک معرفی می‌شود. سادگی ساختار، استفاده از تنها یک کلید نیمه‌هادی قابل کنترل، ارتباط مستقیم بین منبع ورودی و بار، بهره ولتاژ مناسب و عملکرد مطلوب در ردیابی حداکثر توان از جمله مزایای ساختار پیشنهادی می‌باشد. از مهمترین ویژگی‌های ساختار پیشنهادی می‌توان به سری قرار گرفتن خازن خروجی و منبع اصلی اشاره کرد و به عبارتی منبع ولتاژ برای تغذیه بار مسیر کوتاه‌تری را نسبت به مبدل‌های افزایشده مرسوم پیش رو دارد. تحلیل‌های تئوری برای بررسی عملکرد و طراحی مدار قدرت در وضعیت هدایت پیوسته ارائه شده است. برای تأیید عملکرد مطلوب در سیستم فتوولتائیک، نتایج شبیه‌سازی در نرم افزار MATLAB/SIMULINK مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. همچنین یک نمونه آزمایشگاهی ۱۰۰ وات از مبدل ارائه شده ساخته شد.

واژه‌های کلیدی: مبدل DC/DC، افزایشده ولتاژ، پردازش توان جزئی، سیستم فتوولتائیک.

۱- مقدمه

تأمین انرژی رایگان، نامحدود و پاک در تولید انرژی الکتریکی می‌باشد. سلول خورشیدی عنصر اصلی یک سیستم خورشیدی می‌باشد که انرژی تابشی خورشید را مستقیماً به جریان الکتریکی مستقیم تبدیل می‌کند. هر سلول خورشیدی بصورت تقریبی توانی کمتر از ۳ وات تحت ولتاژ ۰/۵ ولت تولید می‌کند. لذا برای استفاده در کاربردهای توان بالا، ماژول فتوولتائیک، پانل فتوولتائیک و آرایه فتوولتائیک ساخته و استفاده می‌شود. برای هر ماژول خورشیدی، دو منحنی مشخصه ولتاژ-جریان (V-I) و ولتاژ-توان (V-P) تعریف می‌شود [۲]. در هر دما و تابش معین، ولتاژ و جریان ماژول خورشیدی می‌تواند مقادیر مختلفی را اختیار کند لذا سیستم فتوولتائیک سیستمی غیرخطی و متغیر با زمان می‌باشد. با توجه به شرایط و بحث دریافت حداکثر توان از سیستم فتوولتائیک سعی می‌شود جریان و ولتاژ ماژول فتوولتائیک در نقطه کار خاصی قرار گیرد. نکته دیگری که از منحنی مشخصه‌های ماژول فتوولتائیک قابل مشاهده است ولتاژ پائین ماژول

با انقلاب صنعتی در اروپا و فراگیری صنعتی شدن در سراسر جهان، استفاده از انرژی‌های فسیلی تجدیدناپذیر روز به روز افزایش یافت. در کنار فواید استفاده از سوخت‌های فسیلی، آلودگی زیست محیطی، گسترش بیماری‌ها، تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی از مهمترین چالش‌های پیش روی جوامع انسانی شد. پس از بروز مشکلات ذکر شده استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و منابع تولید پراکنده به رویکردی جدید تبدیل شد، تا به کشورها علاوه بر پایدار سازی و تنوع بخشی منابع انرژی، در صیانت از محیط زیست با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر کمک گردد [۱]. یک منبع انرژی پراکنده شامل منابع متفاوتی مانند فتوولتائیک، پیل سوختی، میکروتوربین گازی، توربین بادی و غیره است. امروزه انرژی خورشیدی به عنوان منبع انرژی سیستم‌های فتوولتائیک با نام انرژی سبز، یکی از مهمترین منابع

گروه مبدل‌های DC/DC بدون ایزولا سیون معرفی شده‌اند که نسبت به مبدل افزایشدهنده کلاسیک بهره ولتاژ بالاتری را ارائه می‌دهند.

در مراجع [۹-۱۳] ساختارهای افزایشدهنده مبدل DC/DC بدون ایزولاسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. در مرجع [۹] نوعی از مبدل افزایشدهنده ارائه می‌شود که ضمن داشتن جریان پیوسته در بخش ورودی بهره ولتاژ مناسبی از نظر افزایشدهنده ارائه می‌دهد نقطه ضعف این ساختار به نوعی در تعداد قطعات و بویژه استفاده از دو کلید نیمه هادی است. مرجع [۱۰] ضمن داشتن نقاط قوت مرجع [۹] بهره ولتاژ بالاتری نسبت به این مرجع ارائه می‌دهد اما از قطعات بیشتری استفاده می‌نماید. مرجع [۱۱] بهره ولتاژ مشابه با مرجع [۱۰] دارد اما از نظر تعداد قطعات و پیوستگی جریان ورودی نسبت به مراجع [۹] و [۱۰] وضعیت ضعیف‌تری دارد.

در مرجع [۱۲] نوعی از مبدل افزایشدهنده معرفی می‌شود که ارتباط مستقیمی بین منبع انرژی ورودی و بار برقرار است که برای کاربرد در سیستم‌های فتوولتائیک معرفی شده است که مزایای سادگی ساختار، راندمان بالا و هزینه پایین برای آن ذکر شده است. در مرجع [۱۲] توان ورودی سیستم فتوولتائیک به طور مستقیم به خروجی ارسال می‌شود بدون اینکه توسط مبدل پردازش شود و راندمان بالا با داشتن این نوع ارتباط به دست می‌آید. تکنیک استفاده شده تحت عنوان پردازش توان جزئی^۳ یا PPP^۴ معرفی شده است. از نقاط ضعف ساختار مرجع [۱۲] می‌توان به بهره پایین ولتاژ از نظر قابلیت افزایشدهنده اشاره نمود. در مرجع [۱۳] نوعی از مبدل DC/DC افزایشدهنده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که ضمن استفاده از تکنیک PPP و داشتن ارتباط مستقیم بین منبع انرژی فتوولتائیک و بار، بهره ولتاژ بالاتری نسبت به مرجع [۱۲] ارائه می‌دهد. برای ساختار مرجع [۱۲] استفاده از کلیدهای نیمه‌هادی با استرس ولتاژ کمتر از ولتاژ خروجی و نوعی تقسیم جریان از دیگر مزایای ذکر شده می‌باشد. لازم به ذکر است تعداد قطعات مرجع [۱۲] نسبت به مرجع [۱۱] بیشتر می‌باشند.

بحث اصلی در این مقاله بر روی ساختارهای بدون ایزولاسیون که از تکنیک PPP بهره می‌برند متمرکز است. در این مقاله، یک مبدل کلیدزنی بهره ولتاژ بالا برای کاربرد در سیستم فتوولتائیک ارائه شده است که ارتباط مستقیمی بین ورودی و خروجی برقرار است. این مقاله به شرح زیر تنظیم شده است. بخش دوم بررسی عملکرد، تجزیه تحلیل پارامترها و مطالعه تلفات مبدل پیشنهادی را ارائه می‌کند. در بخش سوم، مقایسه‌ای بین مبدل پیشنهادی و برخی از مبدل‌های DC/DC جدید بدون ایزولاسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بخش چهارم به کاربرد در سیستم فتوولتائیک می‌پردازد. در بخش پنجم شبیه‌سازی سیستم مورد مطالعه با نرم‌افزار MATLAB/SIMULINK انجام شده است. بخش ششم نتایج عملی مبدل DC/DC در مقیاس آزمایشگاهی تشریح شده است. بخش هفتم به نتیجه‌گیری اختصاص دارد.

فتوولتائیک می‌باشد. ماژول‌های خورشیدی ولتاژ و جریان DC تولید می‌کند و چون اغلب مصرف‌کننده‌ها متقاضی توان AC می‌باشند، لذا باید از توان DC تولیدی سیستم خورشیدی، توان AC مورد نیاز بار را تأمین نمود. برای اینکار از مبدل‌های DC به AC، استفاده می‌شود. در سیستم‌های تولید پراکنده با توجه به تنوع مبدل‌های الکترونیک قدرت و استراتژی‌های تبدیل توان و تغییر ولتاژ می‌توان ساختارهای متفاوتی برای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه یا بار محلی ارائه نمود [۳]. همچنین برای مبحث تولید توان به صورت هیبریدی ساختارهای متفاوتی ارائه شده است. مبدل‌های DC/DC از جمله مبدل‌هایی هستند که در مبحث تولید توان از منابع انرژی تجدیدپذیر بویژه سیستم فتوولتائیک استفاده می‌شوند [۴].

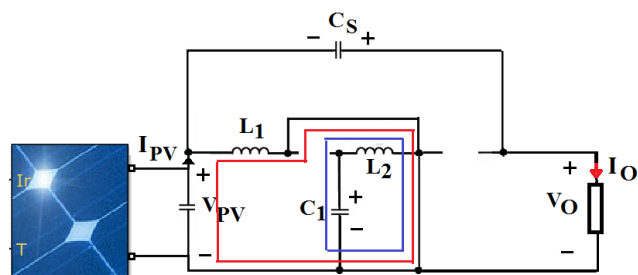
مبدل‌های DC/DC می‌توانند علاوه بر تغییر سطح ولتاژ با کنترل جریان منابع در دستیابی به بازده بیشتر و دریافت حداکثر توان از منابع انرژی تجدید پذیر اقدام نمایند. در این میان مبدل DC/DC افزایشدهنده^۱ با بهره ولتاژ بالا از جمله ساختارهای مهم می‌باشند. در مبدل DC/DC با بهره ولتاژ بالا که از ترانسفورماتور یا سلف‌های تزویج استفاده می‌کنند می‌توانند به بهره ولتاژ بالایی دست یابند. اما مهمترین ایراد این ساختارها حضور ترانسفورماتور و سلف‌های تزویج می‌باشد. ساختارهای بدون ترانسفورماتور مبدل DC/DC می‌توانند به نوعی از حجم و قیمت کل سیستم کاسته و بازده بالاتری را ارائه دهند. اگرچه نبود ایزولاسیون الکتریکی از نقاط ضعف این ساختارهاست.

در مراجع [۵-۸] نمونه‌هایی از مبدل افزایشدهنده با ضریب بهره ولتاژ بالا که از سلف‌های تزویج و به نوعی از ترانسفورماتورها استفاده می‌کنند را معرفی می‌نمایند. از نقاط قوت این ساختارها می‌توان به بهره ولتاژ بالا، پیوستگی جریان و ایزولاسیون اشاره نمود اگرچه در برخی از ویژگی‌ها، برخی ساختارها برتری‌هایی نسبت به یکدیگر دارند. از نقاط ضعف ساختارهای فوق الذکر می‌توان به قرار گرفتن المان‌های زیاد در مسیر جریان دریافتی از منبع به بار اشاره نمود. تعداد بالای المان‌های پسیو و عناصر نیمه‌هادی از جمله مشکلات ساختاری این نمونه‌ها است. در مرجع [۸] برای بار ۲۰۰ وات بازده ۹۶ درصد ذکر شده است که با توجه به حضور سلف‌های تزویج و المان‌های اکتیو و پسیو بازده مناسبی به نظر می‌رسد.

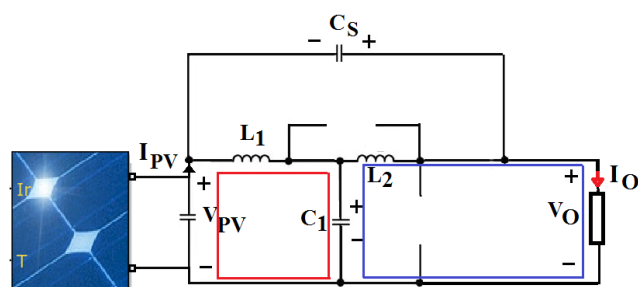
مبدل افزایشدهنده کلاسیک یک ساختار پایه برای مبدل‌های DC/DC با قابلیت افزایشدهنده ولتاژ بدون استفاده از هر نوع ساختار ترانسفورمتری می‌باشد. از ویژگی‌های مبدل افزایشدهنده کلاسیک می‌توان به سادگی، قیمت پایین و بازده بالا اشاره نمود. از جمله نقاط ضعف مبدل افزایشدهنده کلاسیک می‌توان به بهره ولتاژ پایین آن اشاره نمود. اگرچه از نظر تئوری امکان افزایش ولتاژ در مبدل افزایشدهنده با تغییر ضریب وظیفه^۲ تا حد بسیار بالا وجود دارد اما با توجه به افزایش تلفات کلیدزنی و حساسیت سیستم در ضریب وظیفه بالا امکان دسترسی به بهره‌های ولتاژ بالا برای مبدل وجود ندارد لذا در سال‌های اخیر ساختارهایی از

۲- مبدل DC/DC ارائه شده

شکل (۱) ساختار ارائه شده برای مبدل DC/DC، در حالیکه به یک بار اهمی وصل شده است را نشان می‌دهد. اتصال به بار اهمی برای بررسی عملکرد و یافتن رابطه بهره ولتاژ انجام شده است. مبدل ارائه شده دارای یک کلید نیمه‌هادی در ساختار خود است بنابراین با توجه به این مطلب با انجام عملیات کلیدزنی دو حالت، ممکن است اتفاق بیافتند. اهداف اصلی استفاده از مبدل DC/DC دستیابی به بهره ولتاژ مناسب با حداقل المان‌ها اعم از عناصر اکتیو و پسیو و همچنین برقراری ارتباط مستقیم بین منبع انرژی (سیستم مازول خور شیدی) و بار می‌باشد. با توجه به ساختار مبدل DC/DC، این مبدل تحت عنوان DBDPC نام‌گذاری شده است.



شکل (۲): مد (۱) عملکرد مبدل DBDPC



شکل (۳): مد (۲) عملکرد مبدل DBDPC

مد (۱): با روشن شدن کلید نیمه‌هادی (S) دیود D2 در بایاس مستقیم قرار گرفته و روشن می‌شود. همچنین با توجه به ساختار مبدل، دیودهای D1 و D3 در بایاس معکوس قرار گرفته و خاموش می‌شوند. لذا ساختار مداری در مد (۱) به صورت شکل (۲) می‌باشد. برای مد کاری (۱) می‌توان نوشت:

$$V_{L1} = V_{PV} \quad (3)$$

$$V_{L2} = V_{C1} \quad (4)$$

ولتاژ دو سر سلف‌ها مثبت بوده در نتیجه در مد (۱) سلف‌ها شروع به شارژ شدن می‌کنند.

مد (۲): با خاموش شدن کلید (S) دیودهای D1 و D3 روشن و دیود D2 خاموش می‌گردد. شکل (۳) مدار معادل در بازه زمانی مد (۲) را نشان می‌دهد. در این بازه زمانی سلف‌ها به همراه منبع ورودی خازن‌ها را شارژ می‌کنند. برای مد کاری (۲) می‌توان نوشت:

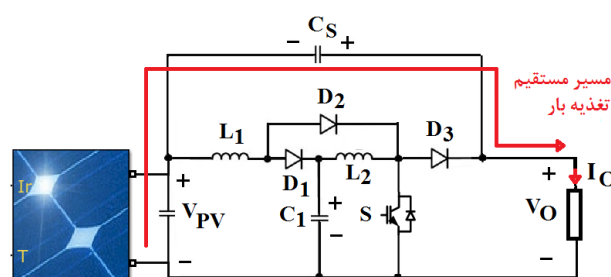
$$V_{L1} = V_{PV} - V_{C1} \quad (5)$$

$$V_{L2} = V_{C1} - V_O \quad (6)$$

بر اساس قانون ولت-ثانیه ولتاژ متوسط سلف‌ها در یک دوره تناوب کلیدزنی برابر با صفر است.

$$\overline{V_{L1}} = \frac{1}{T} \int_0^T V_{L1}(t) dt = 0 \quad (7)$$

$$\overline{V_{L2}} = \frac{1}{T} \int_0^T V_{L2}(t) dt = 0 \quad (8)$$



شکل (۱): مبدل DBDPC

برای ساده‌تر شدن تجزیه و تحلیل عملکرد مبدل DC/DC فرض اولیه این است که مدار در حالت ایده‌آل قرار دارد بدین معنی که از افت ولتاژ روی نیمه‌هادی‌ها و مقاومت داخلی سلف‌ها، خازن‌ها و نیمه‌هادی‌ها صرف‌نظر می‌شود. اندازه سلف‌ها و خازن‌ها به اندازه کافی بزرگ فرض شده است بنابراین رپل ولتاژ خازن‌ها و جریان سلف‌ها قابل چشم‌پوشی بوده و این پارامترها به صورت ثابت در نظر گرفته می‌شوند. عملکرد مبدل در مد هدایت پیوسته بررسی می‌شود چون یکی از اهداف اصلی عملکرد در این مد است و طراحی‌ها برای عملکرد در مد پیوسته صورت می‌گیرد. ولتاژ خروجی مبدل DBDPC برابر است با:

$$V_O = V_{Cs} + V_{PV} \quad (1)$$

۲-۱- بررسی عملکرد و محاسبه بهره ولتاژ

چون در ساختار ارائه شده تنها یک کلید نیمه‌هادی وجود دارد لذا ساختار ارائه شده دارای مدولاسیون ساده‌ای بوده و تنها دو حالت برای کلید وجود دارد. بنابراین دو مد کاری برای مبدل قابل تعریف است. ضریب وظیفه (K) به صورت نسبت زمان روشن شدن (ton) کلید نیمه‌هادی به دوره تناوب (T) کلیدزنی تعریف می‌شود.

$$K = \frac{t_{on}}{T} = t_{on} f_s \quad (2)$$

در معادله (۲)، fs فرکانس کلید زنی می‌باشد. شکل‌های (۲) و (۳) مدهای کاری مبدل DBDPC را نشان می‌دهد.

با فرض ثابت بودن جریان سلفها و جریان بار برای مقادیر موثر جریان خازن ها می توان نوشت:

$$I_{RMS,C1} = \frac{\sqrt{K}}{(1-K)} I_{L2} \quad (22)$$

$$I_{RMS,CS} = \frac{\sqrt{K}}{(1-K)} I_L \quad (23)$$

با توجه به معادلات جریان خازن ها رپیل ولتاژ خازن ها قابل اندازه گیری می باشد.

$$\Delta V_{C1} = \frac{KT}{C_1} I_{L2} \quad (24)$$

$$\Delta V_{CS} = \frac{KT}{C_S} I_L \quad (25)$$

حداکثر ولتاژ قابل تحمل و جریان عبوری از المان های نیمه هادی مانند دیودها و ماسفت ها نقش مهمی در قیمت تمام شده مبدل ایفا می کنند. حداکثر ولتاژ تنش^۶ نیمه هادی ها به صورت روابط (۲۶) تا (۲۸) قابل محاسبه هستند.

$$V_{PIV,S} = V_{PIV,D3} = V_O \quad (26)$$

$$V_{PIV,D1} = V_{C1} = (1-K)V_O \quad (27)$$

$$V_{PIV,D2} = V_O - V_{C1} = KV_O \quad (28)$$

بیشترین جریان عبوری از عناصر نیمه هادی با توجه به جریان سلفها عبارتند از:

$$I_{max,S} = I_{L1} + I_{L2} \quad (29)$$

$$I_{max,D1} = I_{max,D2} = I_{L1} \quad (30)$$

$$I_{max,D3} = I_{L2} \quad (31)$$

برای متوسط جریان عناصر نیمه هادی:

$$I_{av,S} = K(I_{L1} + I_{L2}) \quad (32)$$

$$I_{av,D1} = (1-K)I_{L1} \quad (33)$$

$$I_{av,D2} = KI_{L1} \quad (34)$$

$$I_{av,D3} = (1-K)I_{L2} \quad (35)$$

جریان موثر عبوری از عناصر نیمه هادی:

$$I_{RMS,S} = \sqrt{K}(I_{L1} + I_{L2}) \quad (36)$$

$$I_{RMS,D1} = \sqrt{(1-K)}I_{L1} \quad (37)$$

$$I_{RMS,D2} = \sqrt{K}I_{L1} \quad (38)$$

$$I_{RMS,D3} = \sqrt{(1-K)}I_{L2} \quad (39)$$

با در نظر گرفتن معادلات (۱) تا (۸) برای ولتاژ متوسط سلفها معادلات (۹) و (۱۰) بدست می آیند:

$$0 = \frac{1}{T}[KTV_{PV} + (1-K)T(V_{PV} - V_{C1})] \quad (9)$$

$$0 = \frac{1}{T}[KTV_{C1} + (1-K)T(V_{C1} - V_O)] \quad (10)$$

از معادلات (۹) و (۱۰) رابطه مابین ولتاژ ورودی و خروجی با ولتاژ خازن C_1 قابل استحصال است.

$$V_{PV} = (1-K)V_{C1} \quad (11)$$

$$V_{C1} = (1-K)V_O \quad (12)$$

با قرار دادن مقدار ولتاژ خازن C_1 از معادله (۱۲) در معادله (۱۱) رابطه بهره ولتاژ مبدل DBDPC بدست می آید.

$$V_O = \frac{1}{(1-K)^2} V_{PV} \quad (13)$$

۲-۲- محاسبه جریان و ولتاژ عناصر

از روی مدار معادل در بازه زمانی مد (۱) و عملکرد در ناحیه خطی، برای محاسبه رپیل جریان سلفها می توان نوشت:

$$V_{L1} = V_{in} = \frac{\Delta I_{L1}}{\Delta t} L_1 = \frac{\Delta I_{L1} f_s}{K} L_1 \Rightarrow \Delta I_{L1} = \frac{K}{f_s L_1} V_{PV} \quad (14)$$

$$V_{L2} = V_{C1} = \frac{\Delta I_{L2}}{\Delta t} L_2 \Rightarrow \Delta I_{L2} = \frac{K}{f_s (1-K) L_2} V_{PV} \quad (15)$$

با در نظر گرفتن معادله (۱۳) و با صرف نظر از تلفات مبدل، رابطه جریان منبع (I_{PV}) با جریان بار (I_L) را می توان به صورت معادله (۱۶) نوشت:

$$I_{PV} = \frac{V_O}{R_L(1-K)^2} = \frac{I_L}{(1-K)^2} \quad (16)$$

با توجه به مدارات مدهای عملکردی برای جریان سلفها و خازن ها:

$$i_{C1}(t) = \begin{cases} -I_{L2} & 0 < t < KT \\ I_{L1} - I_{L2} & KT < t < T \end{cases} \quad (17)$$

$$i_{CS}(t) = \begin{cases} -I_L & 0 < t < KT \\ I_{L2} - I_L & KT < t < T \end{cases} \quad (18)$$

$$i_{PV}(t) = \begin{cases} I_{L1} + I_L & 0 < t < KT \\ I_{L1} - I_{L2} + I_L & KT < t < T \end{cases} \quad (19)$$

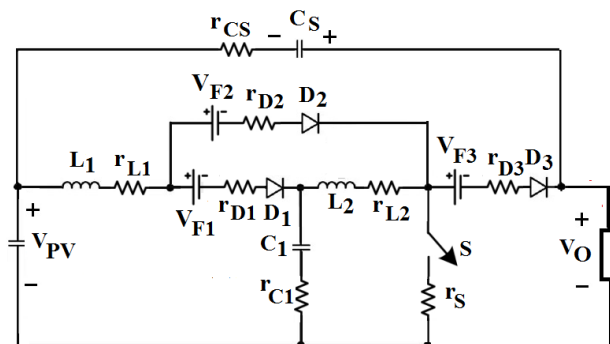
با توجه به صفر بودن جریان متوسط خازن ها رابطه مابین جریان سلفها قابل استحصال است.

$$\overline{V_{C1}} = 0 = \frac{1}{T}[-KTI_{L2} + (1-K)T(I_{L1} - I_{L2})] \quad (20)$$

$$I_{L2} = (1-K)I_{L1} \quad (21)$$

۳-۲- مطالعه تلفات

عناصر پسیو و نیمه‌هادی‌ها دارای مقاومت داخلی هستند. همچنین نیمه‌هادی‌ها دارای نوعی افت ولتاژ در حالت هدایت می‌باشند. این نوع از مقاومت‌ها و افت ولتاژها برای مبدل تلفات اهمی و یا تلفات حالت هدایت ایجاد می‌نمایند. نوع دیگری از تلفات مبدل مربوط به عملیات کلیدزنی است که تحت عنوان تلفات کلیدزنی شناخته می‌شود. در مراجع [۱۱] و [۱۳] در باره تلفات مبدل‌های DC/DC بحث شده‌است. شکل (۴) مدار معادل مبدل DC/DC در حضور مقاومت پارازیتی عناصر و ولتاژ حالت هدایت دیودها نشان داده شده‌است. در شکل (۴) V_F و r به ترتیب مقاومت داخلی عنصر و ولتاژ حالت هدایت دیود هستند. با فرض ثابت بودن و صرف‌نظر از ریپل جریان سلف‌ها مقادیر متوسط و مؤثر جریان سلف‌ها را می‌توان برابر در نظر گرفت.



شکل (۴): مدار معادل برای مطالعات تلفات

برای تلفات اهمی:

$$P_{RL1} = r_{L1} I_{L1}^2 \quad (40)$$

$$P_{RL2} = r_{L2} I_{L2}^2 \quad (41)$$

$$P_{RC1} = r_{C1} I_{RMS,C1}^2 \quad (42)$$

$$P_{RCS} = r_{CS} I_{RMS,CS}^2 \quad (43)$$

$$P_{RS} = r_S I_{RMS,S}^2 \quad (44)$$

$$P_{RD1} = r_{D1} I_{RMS,D1}^2 \quad (45)$$

$$P_{RD2} = r_{D2} I_{RMS,D2}^2 \quad (46)$$

$$P_{RD3} = r_{D3} I_{RMS,D3}^2 \quad (47)$$

برای تلفات حالت هدایت دیودها:

$$P_{VF,D1} = V_{F1} I_{av,D1} \quad (48)$$

$$P_{VF,D2} = V_{F2} I_{av,D2} \quad (49)$$

$$P_{VF,D3} = V_{F3} I_{av,D3} \quad (50)$$

در مورد تلفات کلیدزنی با توجه به فرکانس کلیدزنی (f_D) و ولتاژ کلید در حالت خاموشی (V_S) رابطه (۵۱) نوشته می‌شود.

$$P_{switching} = f_D C_O V_S^2 \quad (51)$$

در رابطه (۵۱) C_O مقدار خازن خروجی است که برای کلیدهای نظیر ماسفت در نظر گرفته می‌شود.

تلفات کل مجموع تلفات اهمی (P_R)، هدایت (P_{VF}) و کلیدزنی ($P_{switching}$) می‌باشد.

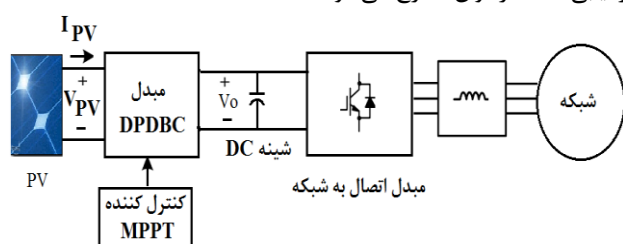
$$P_{Loss} = P_R + P_{VF} + P_{switching} \quad (52)$$

۳- مقایسه مبدل‌ها

در این بخش یک مقایسه بین ساختار DPDBC و ساختارهایی از مبدل‌های DC/DC بدون ایزولا سیون ترانز سفورماتوری انجام می‌شود. بویژه بحث اصلی در خصوص مبدل‌هایی می‌باشد که از تکنیک PPP با ارتباط مستقیم بین ورودی و خروجی بهره می‌برند. شاخص‌های مقایسه‌ای در این بخش شامل تعداد المان‌ها، بهره ولتاژ و ارتباط مستقیم بین منبع ورودی و بار خروجی می‌باشند. جدول (۱)، پارامترهای مقایسه‌ای از مبدل‌ها و مبدل DPDBC را جهت مقایسه ارائه می‌دهد. در جدول (۱) L , C , D و S به ترتیب تعداد سلف، خازن، دیود و کلید نیمه‌هادی اشاره دارند. همچنین در جدول (۱) K به ضریب وظیفه یا چرخه کاری اشاره می‌نماید. ساختارهای پیشنهادی مراجع [۹-۱۱] بهره ولتاژ بالاتری نسبت به سایر مراجع جدول (۱) ارائه می‌دهند اما همه این ساختارها از تعداد قطعات بیشتری نسبت به ساختار پیشنهادی استفاده می‌نمایند.

یکی از مهمترین قطعاتی که تاثیر بیشتر در قیمت تمام شده مبدل می‌گذارد کلید نیمه‌هادی قابل کنترل می‌باشد. هر کلید MOSFET یا IGBT به مدار راه‌اندازی نیاز دارد مدار راه‌انداز از قطعاتی مانند منبع تغذیه، خازن، دیود، مقاومت و آی‌سی راه‌انداز استفاده می‌کند. قیمت آی‌سی راه‌انداز در برخی از موارد از کلید نیمه‌هادی بیشتر است. از طرفی دیگر کلیدها به مدارات محافظ و خنک‌کننده نیز نیاز دارند. از طرفی با افزایش تعداد کلیدها بحث پیچیدگی سیستم کنترل نیز مطرح می‌شود. لذا در مجموع می‌توان گفت با افزایش نیمه‌هادی‌های قابل کنترل و مدار راه‌انداز آن قیمت مبدل افزایش می‌یابد. شکل (۵) مدار راه‌انداز مبتنی بر آی‌سی HCPL-316J را نشان می‌دهد. ساختار پیشنهادی از یک کلید نیمه‌هادی استفاده می‌نماید و از این منظر نسبت به ساختارهای مشروحه در جدول (۱) برتری دارد. همچنین در ساختار پیشنهادی بحث ارتباط مستقیم بین منبع ورودی و بار خروجی مطرح است که اصول تکنیک PPP در آن رعایت شده است این در حالیست که برای مراجع [۹-۱۱] این ارتباط مستقیم وجود ندارد. در مقایسه با مراجع [۱۲] و [۱۳] مبدل DPDBC بهره ولتاژ بالاتری را ارائه می‌دهد در حالیکه مانند مرجع [۱۲] از یک کلید نیمه‌هادی استفاده می‌کند. ساختار مرجع [۱۳] از دو کلید نیمه‌هادی در ساختار خود بهره می‌برد و نسبت به مرجع [۱۲] بهره ولتاژ بالاتری را ارائه می‌نماید. شکل (۶) مقایسه بهره‌های ولتاژ برای ساختار پیشنهادی و مراجع [۱۲] و [۱۳] را نشان می‌دهد.

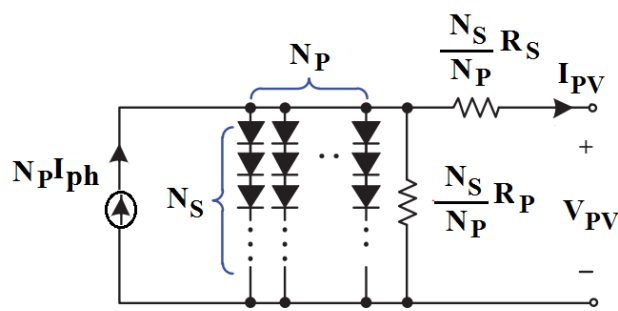
اینورتی با دریافت انرژی از شبکه قدرت در مقدار مشخصی تثبیت می‌گردد. در این مطالعه بحث بر روی عملکرد مبدل DC/DC متمرکز می‌شود و فرض این است که ولتاژ شینه DC ثابت است. ولتاژ خروجی ماژول‌های فتوولتائیک علاوه بر شدت تابش خورشید، به دمای محیط، طول عمر، مشخصه بار و به خصوص ولتاژ خروجی آن وابسته است. بنابراین به ازای شرایط آب و هوایی مشخص تنها در یک نقطه حداکثر توان تحویل می‌گردد. از طرفی عمر کوتاه ماژول‌های خورشیدی و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری اولیه‌ی بالای آنها اهمیت جذب حداکثر توان ممکن را دو چندان می‌کند. لذا در این خصوص بحث ردیابی حداکثر توان مطرح می‌شود.



شکل (۷): سیستم مورد مطالعه فتوولتائیک

۱-۴- مدل و مشخصات ماژول فتوولتائیک

مدل سازی ماژول خورشیدی برای بررسی عملکرد سیستم فتوولتائیک تحت شدت تابش مختلف نور خورشید و دماهای متفاوت انجام می‌شود. شکل (۸) مدل ماژول خورشیدی مورد مطالعه را نشان می‌دهد. با توجه به معادلات ارائه شده (۵۳) برای جریان خروجی ماژول خورشیدی ارائه می‌شود [۱۴].



شکل (۸): مدل ماژول خورشیدی

$$I_{PV} = N_p I_{ph} - N_p I_s \left(e^{\left(\frac{q}{KAT} \left(\frac{V_{PV}}{N_s} + \frac{R_s I_{PV}}{N_p} \right) \right)} - 1 \right) - \left(\frac{V_{PV}}{N_s} + \frac{R_s I_{PV}}{N_p} \right) \frac{N_p}{R_p} \quad (53)$$

در سیستم فتوولتائیک:

I_{ph} بیانگر جریان تابشی خورشید به سطح سلول خورشیدی و برحسب آمپر می‌باشد.

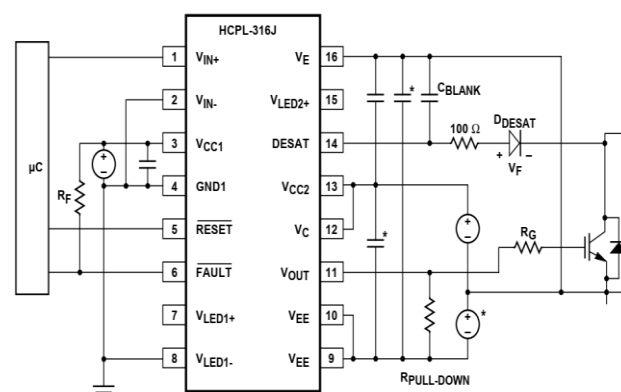
I_s جریان اشباع معکوس دیود برحسب آمپر؛

q بار الکتریکی یک الکترون برابر با 1.6×10^{-19} C ؛

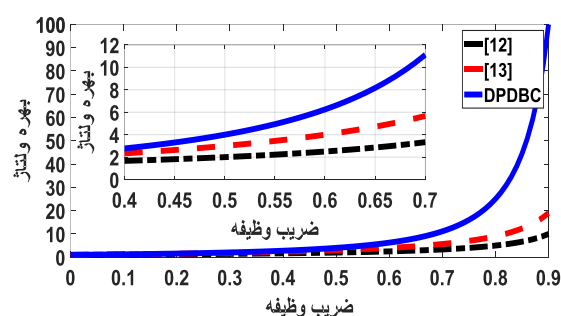
با توجه به مباحث مطرح شده ساختار DPDBC نوعی ساختار بهینه از نظر بهره ولتاژ و استفاده از تکنیک PPP را معرفی می‌نماید.

جدول (۱): مقایسه مبدل‌ها

قابلیت PPPT	بهره	تعداد المان‌ها					مرجع
		جمع	S	D	L	C	
ندارد	$\frac{1+K}{(1-K)^2}$	۱۰	۲	۳	۲	۳	[۹]
ندارد	$\frac{3-K}{(1-K)^2}$	۱۲	۲	۴	۲	۴	[۱۰]
ندارد	$\frac{2+K}{(1-K)^2}$	۱۶	۲	۵	۳	۶	[۱۱]
دارد	$\frac{1}{(1-K)}$	۴	۱	۱	۱	۱	[۱۲]
دارد	$\frac{1+K}{(1-K)}$	۸	۲	۲	۲	۲	[۱۳]
دارد	$\frac{1}{(1-K)^2}$	۹	۱	۳	۲	۲	DPDBC



شکل (۵): یک نمونه راه‌انداز کلید نیمه‌هادی با استفاده از HCPL-316J



شکل (۶): مقایسه بهره ولتاژ

۴- کاربرد در سیستم فتوولتائیک

شکل (۷) سیستم فتوولتائیک مورد مطالعه را نشان می‌دهد. در این مطالعه سیستم فتوولتائیک در حالت متصل به شبکه بررسی شده است. برای تطبیق بار از مبدل افزاینده DPDBC استفاده شده است. در سیستم فتوولتائیک مورد مطالعه خازن شینه DC توسط مبدل

۴-۲- ردیابی حداکثر توان

به منظور افزایش بازده و کارایی سیستم، همواره سعی بر این است که از ماژول خورشیدی در نقطه حداکثر توان بهره‌برداری شود. روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد [۱۵ و ۱۶]. استراتژی رسانیابی افزایش از جمله روش‌های جستجوی قله می‌باشد، اما از رابطه منحصر به فرد منحنی $I-V$ (منحنی ولتاژ جریان) استفاده می‌کند. این روش تخمین جریان و ولتاژ سلول خورشیدی را می‌فهمد و مشتق جریان سلول (dI) و ولتاژ سلول (dV) را اندازه‌گیری می‌کند و از منحنی ولتاژ-جریان PV برای تصمیم‌گیری در مورد خط نقطه کار استفاده می‌شود. در روش رسانیابی افزایشی، کنترلر، تغییرات افزایشی ولتاژ و جریان پنل‌ها را اندازه‌گیری کرده و تغییر ولتاژ را پیش‌بینی می‌کند. این روش به محاسبات بیشتری نیاز دارد ولی تغییرات شرایط را زودتر از روش اغتشاش و مشاهده تشخیص می‌دهد اما مانند روش اغتشاش و مشاهده، باعث نوسان توان خروجی می‌شود. روش رسانیابی افزایشی، با مقایسه افزایش رسانیابی ($\Delta I / \Delta V$) و رسانیابی پنل‌ها (I / V)، ردیابی نقطه حداکثر توان را انجام می‌دهد. هنگامیکه این دو مقدار برابر باشند ($I / V = \Delta I / \Delta V$)، توان خروجی در نقطه حداکثر قرار دارد و با تغییر شدت تابش آفتاب، چرخه تکرار می‌شود. هر زمان که شرایط جوی به سرعت در حال تغییر باشد، بسیاری از تکنیک‌های اندازه‌گام سازگار برای استخراج نقطه حداکثر توان بدون نوسان معرفی شده‌اند. شکل (۱۰) ردیاب حداکثر توان مبتنی بر روش رسانیابی افزایشی با کنترل کننده تناسبی انتگرال‌گیر را نشان می‌دهد. ماژول‌های فتوولتائیک از طریق مبدل‌های DC/DC به لینک خازنی در استراتژی شینه DC وصل می‌شوند. وظیفه این مبدل‌ها تغییر سطح ولتاژ ماژول‌های فتوولتائیک و ایجاد شرایط لازم برای ردیابی حداکثر توان است.

۵- شبیه‌سازی کامپیوتری

دو نمونه از شبیه‌سازی‌ها در این بخش ارائه خواهند شد. از نرم‌افزار MATLAB/SIMULINK برای انجام شبیه‌سازی استفاده شده است. ابتدا مبدل DPDBC شبیه‌سازی شده و سپس عملکرد مبدل DC/DC در یک سیستم تبدیل انرژی فتوولتائیک در مدار اتصال به شبکه مورد شبیه‌سازی و مطالعه قرار می‌گیرد.

۵-۱- شبیه‌سازی مبدل DPDBC

هدف از اولین شبیه‌سازی بررسی عملکرد مبدل DC/DC است. در این بخش نمونه‌ای از مبدل DC/DC مورد بررسی قرار می‌گیرد که توانایی تبدیل ولتاژ ۱۰۰ ولت به ۵۰۰ ولت را داشته باشد. مدار مبدل DC/DC مطابق با شکل (۱) است. توان خروجی مبدل برابر با ۲۸۵۰ وات است. سعی خواهد شد که مبدل به گونه‌ای طراحی شود که ریبیل جریان ورودی و ریبیل ولتاژ خازن‌های خروجی کوچک و قابل صرف نظر باشند و یا به عبارتی $\Delta v_o / V_o$ و $\Delta i_{in} / I_{in}$ کمتر از پنج درصد

K ثابت بولتزمن برابر با J/K با $10^{-23} \times 1/381$ ؛

A عبارت است از ضریب ایده آلی دیود؛

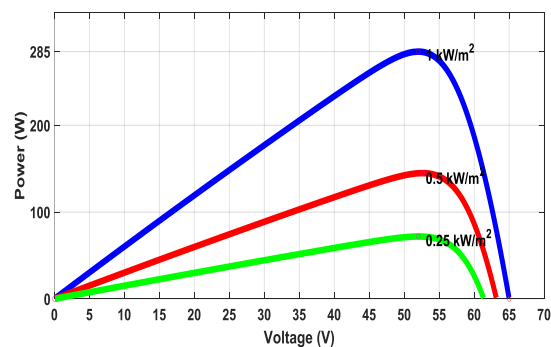
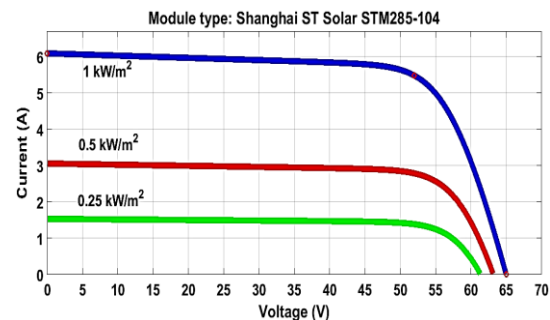
T دما بر حسب درجه کلوین؛

I_{PV} و V_{PV} به ترتیب ولتاژ و جریان ماژول فتوولتائیک می‌باشند.

ماژول PV به کار برده شده در این مقاله ماژول‌های خورشیدی ساخت شرکت Shanghai ST Solar چین می‌باشند. جدول (۲) پارامترهای ماژول خورشیدی مورد استفاده در سیستم فتوولتائیک مورد مطالعه را نشان می‌دهد. سیستم فتوولتائیک دارای ماژول‌هایی با منحنی مشخصه نشان داده شده در شکل (۹) است که برای دمای ثابت ۲۵ درجه سانتیگراد و تابش‌های مختلف ترسیم شده است. این ماژول توان ۲۸۵ وات در تابش ۱۰۰۰ وات بر مترمربع و دمای ۲۵ درجه سانتیگراد تولید می‌کند.

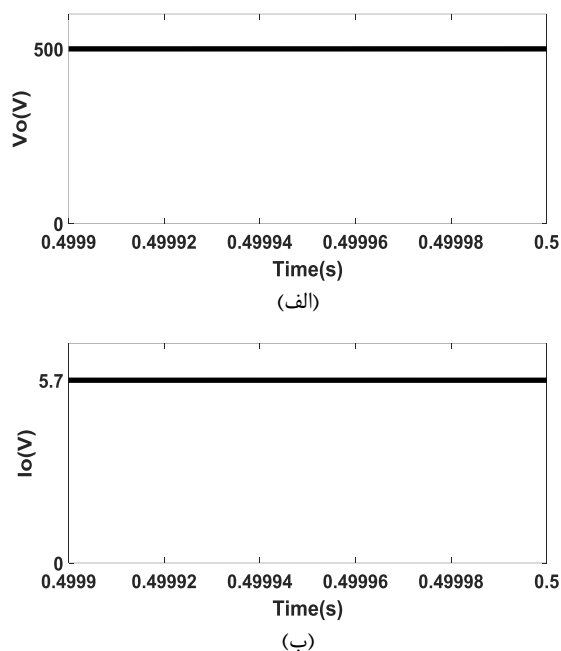
جدول (۲): پارامترهای ماژول خورشیدی

مقادیر		پارامترها
۲۸۴/۹۶W	Pmax	توان پیک (-/+ ۵٪)
۱۰۴	Ncell	تعداد سلول‌های در هر ماژول
۶۵ V	Voc	ولتاژ مدار باز
۵۲ V	Vmp	ولتاژ در نقطه توان ماکزیمم
۶/۰۹A	Isc	جریان اتصال کوتاه
۵/۴۸ A	Imp	جریان در نقطه توان ماکزیمم



شکل (۹): منحنی مشخصه $(P-V)$ و $(I-V)$ ماژول خورشیدی STM285-104 به ازای تابش متغیر و دمای ثابت

برای تبدیل ولتاژ ۱۰۰ ولت به ۵۰۰ ولت باید چرخه کاری در مقداری نزدیک به ۰/۵۵ تنظیم گردد. شکل (۱۱) ولتاژ و جریان خروجی مبدل DC/DC را نشان می‌دهد. ولتاژ و جریان خروجی مقادیر ثابتی هستند. نتایج شبیه‌سازی برای بازه زمانی سه دوره تناوب ارائه شده‌اند.



شکل (۱۱): ولتاژ و جریان خروجی مبدل DC/DC (الف) ولتاژ (ب) جریان

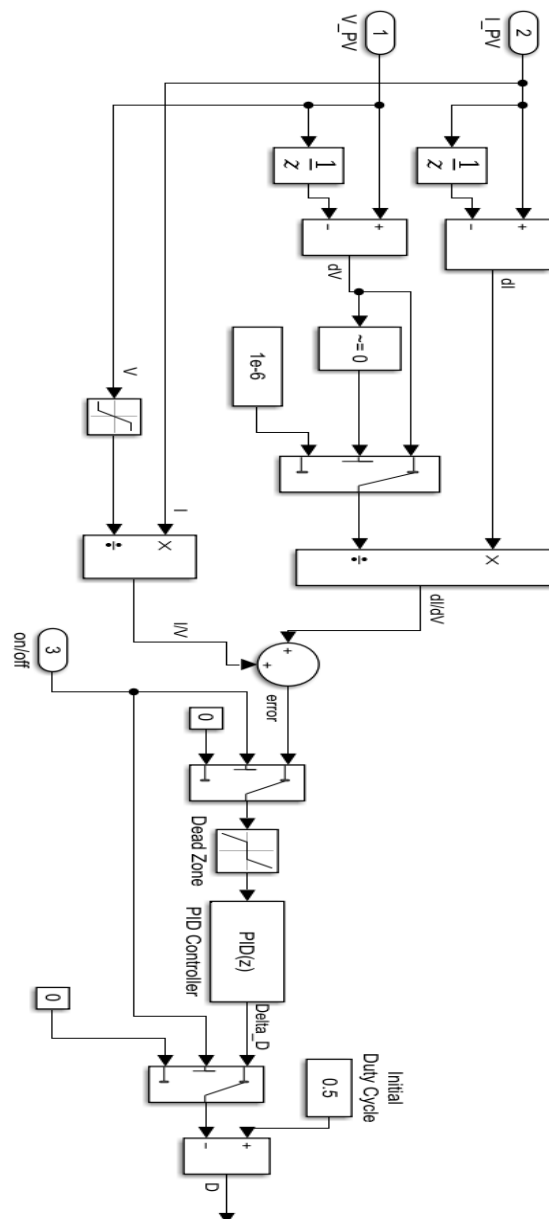
شکل (۱۲) ولتاژها و جریان‌های سلف‌های L_1 و L_2 را نشان می‌دهد. در شکل (۱۲) می‌توان نحوه شارژ و دشارژ سلف‌ها را مشاهده نمود. با قرار گرفتن ولتاژ مثبت در دوسر سلف، سلف در مد شارژ قرار می‌گیرد و بالعکس با منفی شدن ولتاژ دو سر آن، د شارژ می‌شود. همچنین از شکل (۱۲) می‌توان درستی روابط ارائه شده برای جریان سلف‌ها را بررسی نمود. از پارامترهای مهم نشان داده شده در شکل (۱۲) می‌توان به ریبیل جریان سلف‌ها اشاره نمود که ریبیل جریان سلف‌های L_1 و L_2 تقریباً به ترتیب ۱ و ۰/۵ آمپر قابل مشاهده می‌باشند. با توجه به روابط (۱۴) و (۱۵) برای ریبیل جریان سلف‌های L_1 و L_2 می‌توان نوشت:

$$\Delta I_{L1} = \frac{0.55 \cdot 100}{30 \cdot 10^3 \cdot 1.5 \cdot 10^{-3}} = 1.22 \quad (54)$$

$$\Delta I_{L2} = \frac{0.55 \cdot 100}{30 \cdot 10^3 \cdot 0.45 \cdot 7.5 \cdot 10^{-3}} = 0.54 \quad (55)$$

شکل (۱۳) ولتاژها و جریان‌های خازن‌های C_1 و C_S را نشان می‌دهد. در شکل (۱۳) می‌توان نحوه شارژ و دشارژ خازن‌ها را مشاهده نمود. با عبور جریان مثبت از خازن، خازن در مد شارژ قرار می‌گیرد و بالعکس با دریافت جریان منفی خازن د شارژ می‌شود. آنچه که در شکل (۱۳) برای ولتاژ خازن‌ها قابل مشاهده است ریبیل بسیار اندک ولتاژ خازن‌هاست. در حقیقت طراحی به نحوی صورت گرفته است که ریبیل ولتاژ خازن‌ها قابل صرف‌نظر کردن باشد.

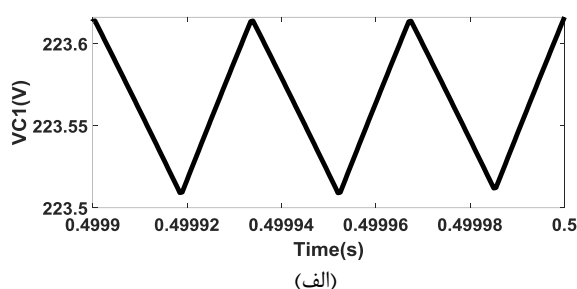
باشند. مقدار پارامترهای مبدل DC-DC در جدول (۳) نشان داده شده است.



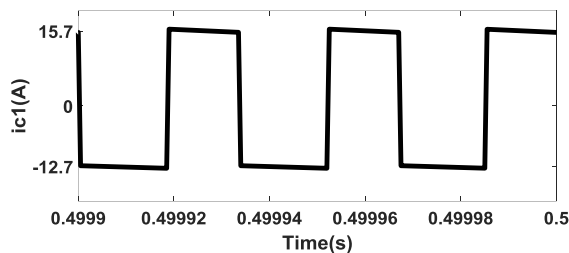
شکل (۱۰): ردیاب حداکثر توان مبتنی بر روش رسانایی افزایشی با کنترل کننده تناسبی انتگرال گیر

جدول (۳): پارامترهای مبدل DPDBC

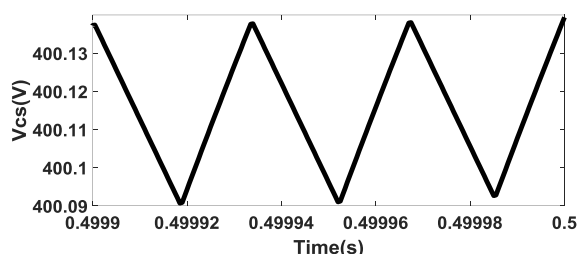
پارامتر	مقدار
L_1 و L_2	۱/۵ و ۷/۵ میلی هانری
C_S و C_1	۲۲۰۰ میکروفاراد
بار	مقاومتی، ۲۸۵۰ وات
فرکانس کلیدزنی	۳۰ کیلو هرتز
ولتاژ منبع	۱۰۰ ولت
ولتاژ بار	۵۰۰ ولت



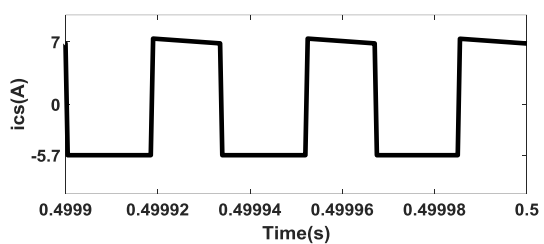
(الف)



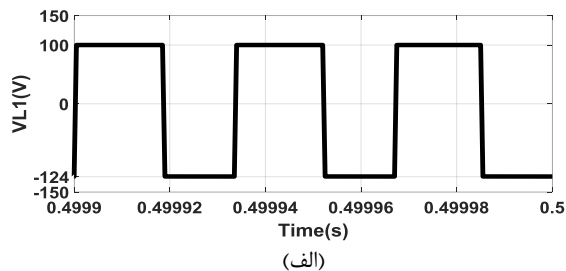
(ب)



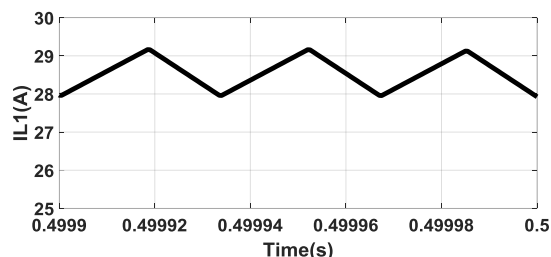
(ج)



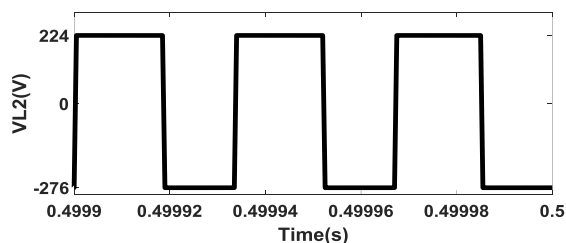
(د)



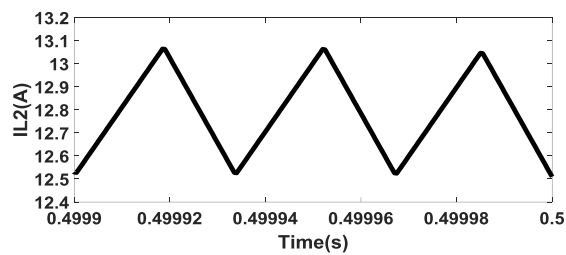
(الف)



(ب)



(ج)



(د)

شکل (۱۲): ولتاژها و جریان‌های سلف‌های L_1 و L_2

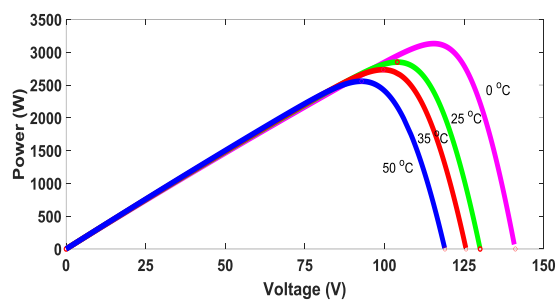
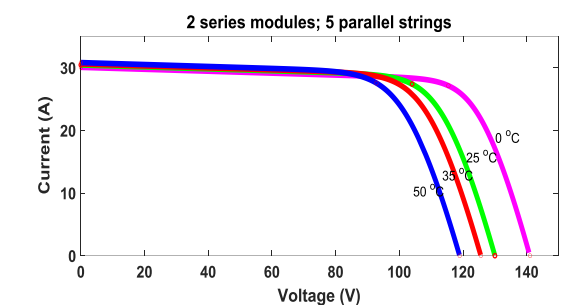
شکل (۱۳): ولتاژها و جریان‌های خازن‌های C_1 و C_s

۲-۵- شبیه‌سازی عملکرد در سیستم خورشیدی

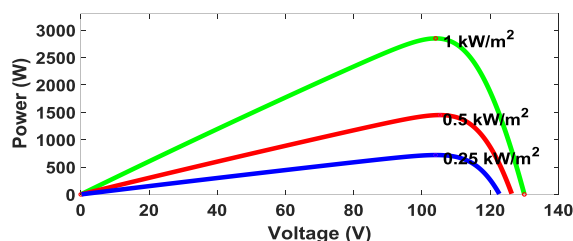
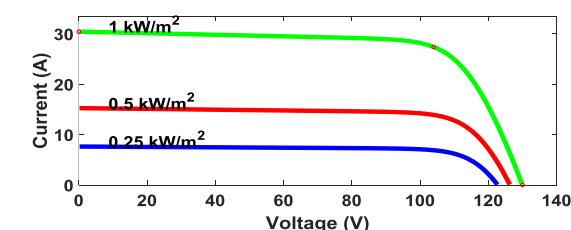
در این شبیه‌سازی یک سیستم فتوولتائیک مطابق با شکل (۷) در نظر گرفته می‌شود. هدف تزریق توان تولیدی از منابع فتوولتائیک در مد اتصال به شبکه است. ولتاژ شینه DC در مقدار ۵۰۰ ولت ثابت نگه داشته می‌شود. منابع فتوولتائیک از طریق مبدل DPDBC به شینه DC وصل شده‌اند. پارامترهای مبدل DPDBC در جدول (۳) داده شده‌اند.

سیستم فتوولتائیک دارای مازول‌هایی با منحنی مشخصه نشان داده شده در شکل (۹) است. این مازول توان ۲۸۵ وات در تابش ۱۰۰۰ وات بر مترمربع و دمای ۲۵ درجه سانتیگراد تولید می‌کند. در آرایه استفاده شده تعداد ۵ رشته با هم موازی شده‌اند که در هر رشته ۲ مازول وجود دارد.

ولتاژ و جریان عناصر نیمه‌هادی در شکل (۱۴) نشان داده شده‌اند. از شکل (۱۴) می‌توان نحوه روشن و خاموش شدن دیودها با توجه به کلیدزنی عنصر نیمه‌هادی قابل کنترل را مشاهده نمود. شکل (۱۴) درستی روابط ارائه شده برای حداکثر ولتاژ قرار گرفته بر روی عناصر نیمه‌هادی و حداکثر جریان عبوری از این عناصر را تصدیق می‌نماید. برای مثال طبق رابطه (۲۶) حداکثر ولتاژ قرار گرفته بر روی کلید نیمه‌هادی قابل کنترل برابر با ولتاژ خروجی است که در شکل (۱۴الف)) قابل مشاهده می‌باشد. جریان عبوری از کلید نیمه‌هادی در حالت هدایت طبق شکل (۱۴الف)) برابر با ۴۱ آمپر می‌باشد که درستی رابطه (۲۹) را اثبات می‌نماید. در رابطه (۲۹) حداکثر جریان عبور از کلید نیمه‌هادی برابر با مجموع جریان سلف‌های L_1 و L_2 بیان شده است. در شکل (۱۲) جریان سلف‌های L_1 و L_2 به ترتیب ۱۲/۷ و ۲۸/۵ آمپر می‌باشد که مجموع این جریان‌ها تقریباً ۴۱ آمپر خواهد شد.



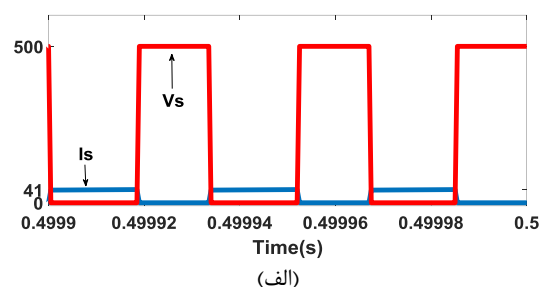
(الف)



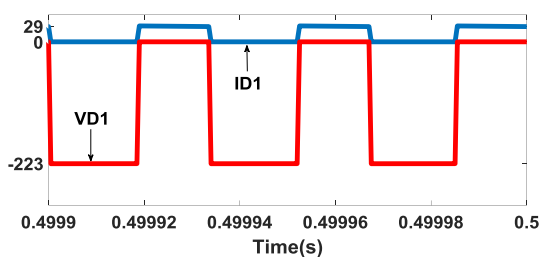
(ب)

شکل (۱۵): منحنی مشخصه (I-V) و (P-V) آرایه خورشیدی به ازای (الف) دمای متغیر تابش ثابت، (ب) تابش متغیر و دمای ثابت

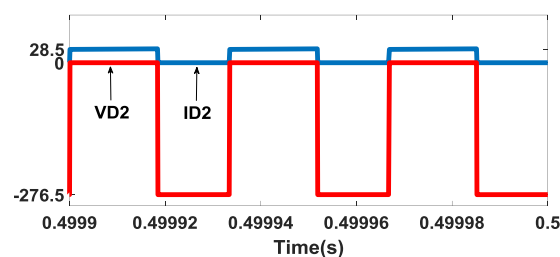
تغییر سطح ولتاژ آرایه و رساندن به سطح مطلوب ولتاژ لینک خازنی وظیفه مبدل DC/DC است. شکل (۱۶) تزریق توان به شبکه توسط سیستم فتوولتائیک را نشان می‌دهد. در شکل (۱۶) توان تولیدی توسط سیستم فتوولتائیک با تغییرات تابش و دما تغییر می‌کند. شکل (۱۶الف)) تغییرات تابش را نشان می‌دهد. تابش از مقدار ۱۰۰۰ وات بر مترمربع به ۲۵۰ وات بر مترمربع می‌رسد سپس مجدد به میزان سطح ۱۰۰۰ وات بر مترمربع بر می‌گردد. شکل (۱۶ب)) تغییرات دما را بین دو مقدار ۲۵ و ۵۰ درجه سانتیگراد نشان می‌دهد. شکل (۱۶ج)) بیانگر توان دریافتی از سیستم فتوولتائیک می‌باشد. با توجه به منحنی مشخصه‌های آرایه فتوولتائیک نشان داده شده در شکل (۱۵) برای شرایط تابش برابر با ۱۰۰۰ وات بر مترمربع و دمای ۲۵ درجه سانتیگراد توان حداکثر ۲۸۵۰ وات می‌باشد. لذا طبق شکل



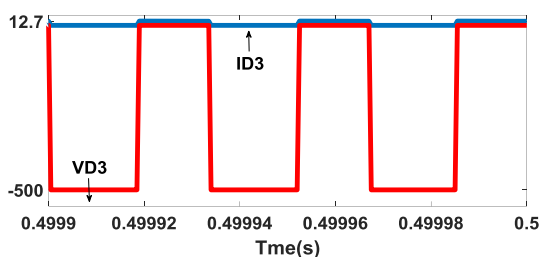
(الف)



(ب)



(ج)



(د)

شکل (۱۴): ولتاژها و جریان‌های عناصر نیمه‌هادی (الف) کلید، (ب) دیود D_1 ، (ج) دیود D_2 ، (د) دیود D_3

شکل (۱۵) منحنی مشخصه‌های ولتاژ- جریان و ولتاژ-توان برای شرایط تابش و دمای متغیر برای آرایه‌های فتوولتائیک را نشان می‌دهد. شکل (۱۵الف)) مشخصه‌های آرایه خورشیدی به ازای دماهای متغیر و تابش ثابت ۱۰۰۰ وات بر متر مربع را نشان می‌دهد. مشخصه‌های آرایه خورشیدی به ازای تابش‌های متغیر و دما ثابت ۲۵ درجه سانتیگراد در شکل (۱۵ب)) نمایش داده شده‌اند. با توجه به منحنی‌های شکل (۱۵) می‌توان گفت برای یک آرایه ولتاژ نقطه حداکثر توان بین ۹۰ تا ۱۲۰ ولت است. در حقیقت آرایه فتوولتائیک یک منبع ولتاژ متغیر است که با توجه به شرایط تابش و دما مقدار آن تغییر می‌کند. مبدل DPDBC با تغییر ضریب وظیفه ولتاژ و جریان سیستم فتوولتائیک را در نقطه کار مطلوب تثبیت می‌نماید.

۶- نتایج عملی

یک مدار آزمایشگاهی برای مبدل‌های DC/DC تهیه شد که بر روی این مدار یک کلید قابل کنترل به همراه مدارات راه‌انداز، دیود، خازن، سلف و میکروکنترلر تعبیه گردید. شکل (۱۷) مدار آزمایشگاهی برای مبدل‌های DC/DC را نشان می‌دهد. برای ساخت راه‌انداز کلیدهای قابل کنترل از درایورهای نوع HCPL-316j استفاده گردید. آی سی HCPL-316j یک درایور ۱۶ پایه می‌باشد که مناسب برای مدار راه‌انداز یک IGBT یا یک ماسفت قدرت می‌باشد. جدول (۴) پارامترهای ساختار ارائه شده برای مبدل DPDBC را نشان می‌دهد.



شکل (۱۷): مدار آزمایشگاهی برای مبدل‌های DC/DC

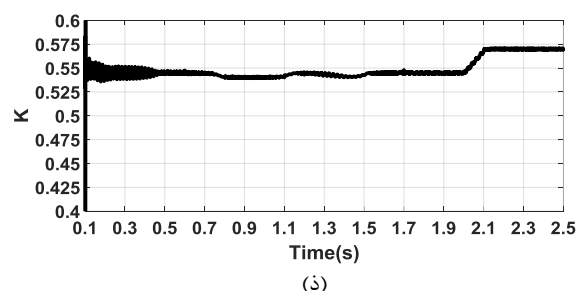
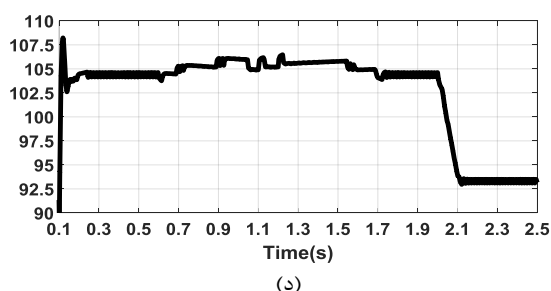
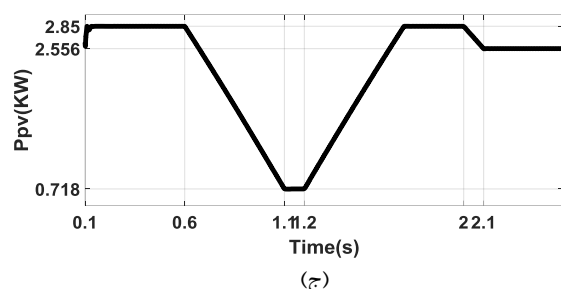
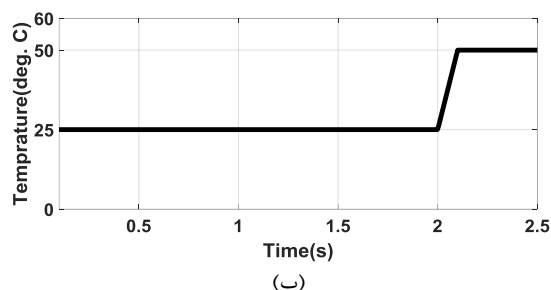
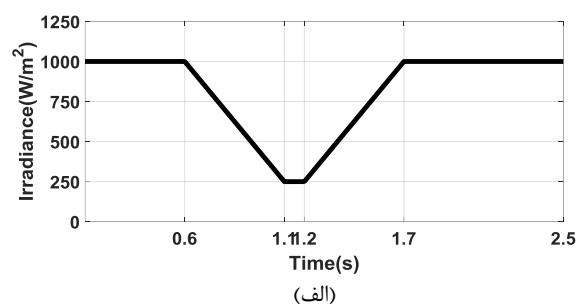
برای منبع تغذیه اصلی از یک منبع ولتاژ سوئیچینگ با ولتاژ ۴۸ ولت استفاده گردید. برد آردوینو Arduino DUE با پردازنده ARM برای انجام عملیات کلیدزنی استفاده گردید.

شکل (۱۸) نتایج تجربی برای بخش DC-DC اولین ساختار ارائه شده را تشریح می‌کند. سلکتور زمان در اسیلوسکوپ بر روی ۱۰ میکرو ثانیه تنظیم شده است. ولتاژ فرمان یا ولتاژ گیت-سورس برای کلید مبدل DPDBC در شکل (۱۸الف) نشان داده شده‌اند. در انجام آزمایشات ضریب وظیفه بر روی مقدار نزدیک به ۵۴ درصد تنظیم شده است. با توجه به فرمان ارسالی جریان سلف‌ها و ولتاژ خازن‌ها در شکل‌های (۱۸ب) و (۱۸ج) نشان داده شده‌اند. شکل (۱۸د) نشانگر ولتاژ خروجی مبدل DC/DC است که یک ولتاژ ثابت می‌باشد.

جدول (۳): پارامترهای مبدل DPDBC

پارامتر	مقدار
L_1 و L_2	۱/۵ و ۱/۵ میلی هانری
C_1 و C_S	۲۲۰ میکروفاراد
بار	مقاومتی، ۱۰۰ وات
فرکانس کلیدزنی	۳۰ کیلو هرتز
دیود	BYP302
ماسفت	IRFP250
میکروکنترلر	Arduino DUE
ولتاژ منبع	۴۸ ولت
ولتاژ بار	۲۲۰ ولت

(۱۵ج)) ردیابی حداکثر توان به خوبی انجام شده است. شکل (۱۶د)) ولتاژ آرایه فتوولتائیک و شکل (۱۶ذ)) ضریب وظیفه (K) را نشان می‌دهند که با توجه به رابطه (۱۳) بهره ولتاژ، تغییر سطح ولتاژ آرایه و رساندن به سطح مطلوب ولتاژ لینک خازنی یعنی ۵۰۰ ولت به خوبی انجام شده است.



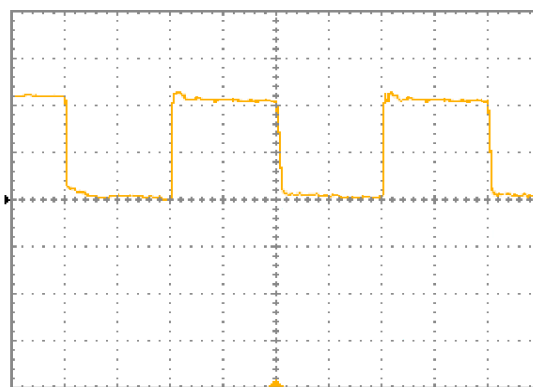
شکل (۱۶): عملکرد مبدل در سیستم فتوولتائیک (الف تابش، ب دما، ج توان تزریقی، د ولتاژ آرایه، ذ ضریب وظیفه (K)).

۷- نتیجه

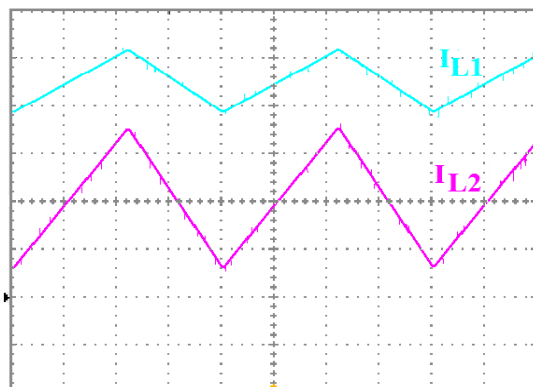
در این مقاله، یک ساختار از مبدل های DC/DC افزایش دهنده ولتاژ از مبدل های بدون ایزولاسیون ترانسفورماتوری معرفی گردید. از مهمترین ویژگی های ساختار ارائه شده می توان به سادگی و استفاده از تکنیک پردازش توان جزئی اشاره نمود. بر طبق تکنیک پردازش توان جزئی ارتباط الکتریکی کوتاه تر مابین ورودی و خروجی باعث افزایش بازده مبدل پیشنهادی می شود. از دیگر ویژگی های ساختار پیشنهادی می توان به استفاده از یک کلید نیمه هادی اشاره نمود. مبدل پیشنهادی با تعداد المان های کمی به بهره ولتاژ بالا دست یافته است. مطالعات محاسبات جریان و ولتاژ، محاسبات تلفات، مقایسه با ساختارهای جدید هم خانواده، شبیه سازی کامپیوتری و ساخت نمونه آزمایشگاهی در مقاله انجام شده است.

مراجع

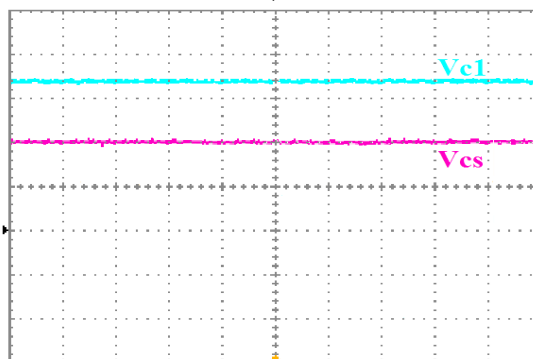
- [1] L. Tian, Q. Ye, Z. Zhen, "A new assessment model of social cost of carbon and its situation analysis in China", Journal of Cleaner Production, Vol. 211, pp. 1434-1443, 2019.
- [2] M. Ding, Z. Xu, W. Wang, X. Wang, Y. Song, and D. Chen, "A review on China's large-scale PV integration: Progress, challenges and recommendations", Renewable Sustain. Energy Rev., Vol. 53, pp. 639-652, Jan. 2016.
- [3] M.R. Banaei, E. Salary, "Application of multi-stage converter in distributed generation systems", Energy Conversion and Management, Vol. 62, pp. 76-83, 2012.
- [4] V. Fernão Pires, A. Cordeiro, C. Roncero-Clemente, S. Rivera, and T. Dragicevic, "DC-DC Converters for Bipolar Microgrid Voltage Balancing: A Comprehensive Review of Architectures and Topologies", IEEE J. Of Emerg. And Select. Topics In Power Electron, Vol. 11, No. 1, pp. 981-998, 2023.
- [5] L. He, Z. Zheng, and D. Guo, "High step-up DC-DC converter with active soft-switching and voltage-clamping for renewable energy systems", IEEE Trans. Power Electron., Vol. 33, No. 11, pp. 9496-9505, Nov. 2018.
- [6] M. E. Azizkandi, F. Sedaghati, H. Shayeghi, and F. Blaabjerg, "Two-and three-winding coupled-inductor-based high step-up DC-DC converters for sustainable energy applications", IET Power Electron., Vol. 13, No. 1, pp. 144-156, 2020.
- [7] H. Radmanesh, M. R. Soltanpour, and M. E. Azizkandi, "Design and implementation of an ultra-high voltage DC-DC converter based on coupled inductor with continuous input current for clean energy applications", Int. J. Circuit Theory Appl., Vol. 49, No. 2, pp. 348-379, 2021.
- [8] S. Hasanpour, Y. P. Siwakoti, and F. Blaabjerg, "A New High Efficiency High Step-Up DC/DC Converter for Renewable Energy Applications", IEEE Trans. On Indust. Electron., Vol. 70, No. 2, pp. 1489-1500, 2023.
- [9] S. V. K. Naresh, S. Peddapati, and M. L. Alghaythi, "Non-isolated high gain quadratic boost converter based on Inductor's asymmetric input voltage", IEEE Access, vol. 9, pp. 162108-162121, 2021.
- [10] N. Subhan, Z. May, KH. Alam, I. Khan, A. Hossain, AND S. Mamun, "An Improved Non-Isolated Quadratic DC-DC Boost Converter With Ultra High Gain Ability ", IEEE Access, Vol. 11, pp. 11350-11363, 2023.
- [11] T. Jalilzadeh, N. Rostami, E. Babaei, and M. Maalandish, "Nonisolated Topology for High Step-Up DC-DC



(الف)



(ب)



(ج)



(د)

شکل (۱۸): نتایج تجربی (الف) ولتاژ گیت-سورس ماسفت (20V/div)، (ب) جریان سلف ها (0.5V/div)، (ج) ولتاژ خازن ها (50V/div)، (د) ولتاژ خروجی (50V/div)

زیر نویس ها

- ¹ Boost
- ² Duty cycle
- ³ Partial Power Processing
- ⁴ Partial Power Processing
- ⁵ Double boost Direct Power Converter
- ⁶ Continuous Conduction Mode
- ⁷ Peak Invers Voltage

- Converters", IEEE J. Of Emerg. And Select. Topics In Power Electron., Vol. 11, No. 1, pp. 1154-1168, 2023.
- [12] M.S. Agamy, M. Harfman-Todorovic, A. Elasser, S. Chi, R. L. Steigerwald, J.A. Sabate, A.J. McCann, L. Zhang, F. J. Mueller, "An Efficient Partial Power Processing DC/DC Converter for Distributed PV Architectures", IEEE Trans. Power Electron., vol. 29, no. 2, pp. 674-686, 2014.
- [13] E. Salary, M. R. banaei and A. Ajami, "Step-Up DC/DC Converter Based on Partial Power Processing", Gazi University Journal of Science, Vol. 28, pp. 599-607, 2015.
- [14] M. A. Mahmud, H. R. Pota, and M. J. Hossain, "Dynamic stability of three-phase grid-connected photovoltaic system using zero dynamic design approach", IEEE J. Photovolt., vol. 2, no. 4, pp. 564-571, Oct. 2012.
- [15] R. Babu Bollipo, S. Mikkili, and P. Kumar Bonthagorla, "Hybrid, Optimal, Intelligent and Classical PV MPPT Techniques: A Review ", CSEE J. OF Pow. And Energy Sys., Vol. 7, No. 1, pp. 9-32, JANUARY 2021.
- [16] M. A. Abdourraziq, M. Maaroufi, and M. Ouassaid, "A new variable step size INC MPPT method for PV systems", in Proceedings of 2014 International Conference on Multimedia Computing and Systems (ICMCS), Marrakech, 2014, pp. 1563-1568.

رزومه



ابراهیم سالاری در خرم آباد متولد شده است (۱۳۵۸). تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی مهندسی برق- قدرت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول (۱۳۸۶)، کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت از شهید

مدنی آذربایجان (۱۳۸۹) و دکتری مهندسی برق- قدرت از شهید مدنی آذربایجان (۱۳۹۳) سپری کرده است. فعالیت های پژوهشی و علاقه مندی ایشان در زمینه مبدل های الکترونیک قدرت، کیفیت توان، و انرژی های تجدید پذیر است و در حال حاضر استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشد.



سجاد سبزی در کوهدشت متولد شده است (۱۳۶۶). تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی مهندسی برق- الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد (۱۳۸۹) و کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی از

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (۱۳۹۹) سپری کرده است و در حال حاضر دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق- قدرت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشد. فعالیت های پژوهشی و علاقه مندی ایشان در زمینه های اتوماسیون صنعتی، درایو، مبدل های الکترونیک قدرت و انرژی های تجدید پذیر است.

Providing voltage boosting DC/DC converter with direct connection between source and load

Ebrahim Salary^{1*}, Sajad Sabzi²

*1- Department of Electrical Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran,
ebrahim.Salary@iau.ac.ir

2- Department of Electrical Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran,
sajad122000@yahoo.com

Abstract: In this paper, a DC/DC converter with high gain voltage for application in photovoltaic (PV) system is suggested. The proposed structure has the advantages of the simplicity of the structure, the use of only one controllable semiconductor switch, direct connection between the input source and the load, suitable voltage gain and optimal performance in tracking the maximum power in photovoltaic systems. One of the most important features of the proposed structure is the series placement of the output capacitor and the main source. In other words, the voltage source has a short path to feed the load compared to conventional step-up converters. Theoretical analyzes are presented to investigate the performance and design of the power circuit in the continuous conduction state. To confirm the optimal performance in the photovoltaic system, the simulation results have been evaluated in MATLAB/SIMULINK software. Also, a 100 W laboratory sample of the proposed converter was made.

Keywords: DC/DC converter, voltage boost, partial power processing, photovoltaic system

